

573PФ5 (умяг радиомет. старание)

Надр. на 3 дел (всход 3 тана)

"EFD - разреш. стенки

"CS/РВМ подбор микрошхем (10циклов переадреса) на всход до V=25 вольт

Долговечность до 2-3 лет. После намотку постепенно затираются. Импортные до 10 лет и больше.

Бойков Алексей Васильевич (Биска) бл. мит. авантёр. Знать структурную схему.

Блоки питания ПЭВМ ЕС-1841.

В ПЭВМ нах. 2 основных блока питания БП. Один БП в базовом модуле. Служит для питания микст системных модулей. Осн. питание +5в. и ±12в. Конструкт. расположен с левой стороны базового блока. Пит. 220в - 1 фаза. В разветвленном кабеле. Сама ПЭВМ не имеет своего заземления. Излучр. нейтраль, или защитные заземление. В основном бло в базовом блоке нах. вентилятор обдува 220в. Вкл. произв. на задний стенке. Чтобы снять блок питания, снизу отвернуть 4 винта и отсоединить развет. 12 вольтовый. Может питать монитор (12)

Второй блок питания. расположен в блоке накопителей. Соедин. Служит для питания винчестера и тв.НГМД. Они являются имп. ист. питания

Блок питания базового блока (2130 часть 2) структ. сх. 1981 Альбом 6 - проект. сх.

Ширр. Б.П. Баз. Мод. ЕС-1841. E001. E15.087.021-01 } Зависит от типа. в зависимости от типа. В блоке накопителей 1841. E001. E15.087.022. Характер-ки Б.П.

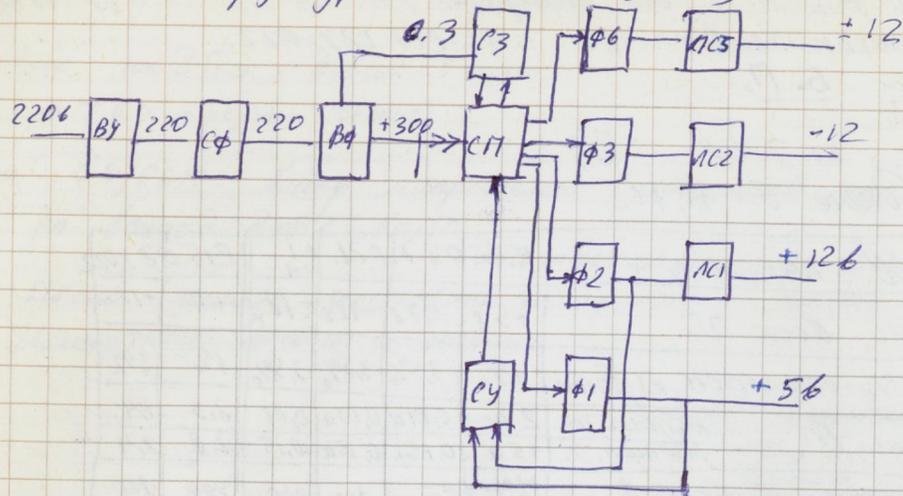
Экспресс. от 220в. +10% -15% Выходные V Б.П.

Максименов. параметры	E15.087.021.01	01	04	E15.087.022	
Ном. знат. вых V	+5в	+12в	-12в	+12в	+5
Допуск. ±% отклонен. от ном.	1%	3,5%	3,5%	3,5%	1%
Ток нагрузки А	2а	0,01а	0,01а	0,01	2,3
	15а	0,65а	0,15а	0,15	2,8
Размах пульсации Vвх в мв.	100	200	200	200	50
Ток сраб. защиты от перегрузок	17-19	-	-	-	-

Пит. ±12 не имеет заземл. связи с землей. Допуск отклон. в Vвх. в ±12, +12в. зависит от отклон. в импор. сх. КР142 и Н8В 15в.

Б.П. должен сохр. работоспос. при перегрузке и к.з. 1. Ток кор. зам. Б.П. Б. Блока не должен превышать 22а. 2. Ток к.з. для Б.П. Б. Малот не должен превышать 8а. Потребл. эл. тока от сети Бл. П. Б. Блока 1,5а Бл. П. Б. Нах 1,2а

Структурная схема (5кн.)



Устройство и работа бл. пп.

Б. п. 1841 Б. п. предст. собой многокан. вторич. и. п. с широкошп. регул. напряжений $U_{\text{нн}}$ (5, 12, -12, ±12) на каналу 5в (+12в), т.е. извлекается дшт.

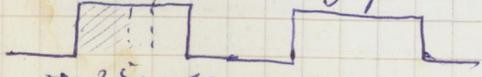
управляющего импульса, с без трансформат. входом. Преимущества: меньше габариты и больше КПД, и более безопасны.

Первичная цепь не имеет связи с землей. Высшее шп. напряжение до 800в.

Перв. и втор. цепи развязаны через трансформатор. Рекомендуется для измер. напряж. подк. осцилл. через транс-тор.

Т.к. шп. ист. питан. критичны к холостому ходу при переходе к +5в неох. подпит. нагрузоч. сопротив.

CU - сх. управление управл. скважностью (40кн) макс. шп. управление 12мкс



→ 2.5 мкс
мох. делител. регул.
в сторону уменьшения

Описание структурной схемы

Составные части:

1. ВУ - входной узел - разъем электропитания с кабелем
СА предохран. 2амп 4а.

2. СФ - сетевой пассив. подавл. фильтр. обеспечивает снижение напряж. радиопомех, от 40000 Гц (нашп.) до 100 Гц. ВУ и СФ расположены на первой плате (металл. экране - СФ)

3. ВФ - сетевой выпрям. и сглаживающий фильтр. обеспечивает выпрямл. перем. напряж. сети $U_{\text{нн}} = 220$. ВД (выб. мост) КЦ 405 А. R4 - цепь плавного для широких запусков (R4). Сглаживание пульсации выпр. напр. - накопительн. емкости C2...C8 (ограничение ампл. тока заряда - R2, R5)

Цепь беззаряда емкостей: тиристор VT1 T112 необходим для дальнейшей подзарядки емкостей после вынот. Б. п. в работу. Остальные элементы см. в схеме. - это всё на одной плате.

4. СЗ - схема запуска и защиты от перегрузок по току тр-ра. VT1.

Сх. зап. выполнен. на микросборке 04ЕУ13 (или ЕУ998) реализует след. функции:

1 - запуск силового преобразователя полож. шп. - должен прийти с 04 кнопки (тр-р 808)

Для ЕУ998 это будет 23 ножка, 2. Огр. амплит. коллект. тока (не более 3а) рез. R10 (ограничивает по первому шп.)

Запрет запуска силового преобразователя до снижения заряда C2...C8 - 14 ножка и 10 - на ТВ2.1 (транз.) (для 998 н. 14 и 12)

Микросборка ЕУ13 max ср-це 2000 (сх. схема)

5. СП - силовой преобразователь Транс ТВ1 - феррит шп. (феррит Ш-образной)

Активн. элемент VT1 КТ840 АА } связь через тр-р VT2 КТ808 АМ } связь через тр-р

VT1 и VT2 работают в противофазе - 1откр, 2откр, 2откр, 1закр.

СП - обеспечивает преобраз. = 220в зарядных емкостей; на C2...C8 max в - 340в. в заданное в по величине тока перемещное преобраз. в с регулируемой скважн. при 5-

6. Далее де модулятор каналов. VD 9...17 (KD212A) (KD213A)
Далее зарядные емкости для стабилизации пульсаций

7. Линейный стабилиз.
обеспеч. стабил. U каналов, не охватываемые обратной связью КРЭЗЕН8В

8. СУ - сх. управления DA6 04EY12 (EY999)

Управл. через усил. мощности VT2 КТ808АМ путем регулировки скважности выработки импульсов в зависимости от разн. в канале +5в и в порогом напряж. в мк.сб. есть защита по перегрузкам за счет сниж. протекам. Ik VT1

Описание Б.П. прик. схем

При описании Б.П. в скобках будут элементы Б.П. Б. Напол. После вкл. мп. ~220 через ВУ 51 подается на диодный мостик. Далее ~ преобр. в "U" проих. заряд емк. C2...C8 [C4...C16].

Макс. U = 340в. Цель замык. через R2 (R3) R5 прихит с R5 сглаживает U, пропариз. Ii зарядка емкостей Это напряж. служит для микросб. DA1 запрета на включен. силового преобразоват. до снижения тока заряда -12; 28 мА. (Этот ток пропор. U 28 и 29 ном. порядка 1; 2 в. т.е. U емкостей должн. достигать 200в.)

Момент t1. После этого сигнал запрета снимается и микр.сб. DA1 выработ. запуск. импульс. Ножка 04. Ток запуска ~4мА поступает на базу слов. тр-ра VT1, ~~открывает~~ и открывает его. В этот момент по обмотке TV 14 16-10 протекает ток, который не должен превышать 3а. При превышении 3а на DA1 ножки 22 и 26 формируют сигнал запрета, который поступ. на 14 ножку, мунт. обмотку TV2-1. VT1 при этом должен закрыватся

формируют сигнал запрета, который поступ. на 14 ножку, мунт. обмотку TV2-1. VT1 при этом должен закрыватся

Обновременно при протекании тока в обмотке 16-10 прои. прот. тока в обм. TV1-1 обм. 20-18. Обмотки намотан. симметрично U на обм. 20-18 создает шп. для управл. электрода тиристора. Тир-тор отключается, мунтар. R2, R5.

При вклот. силового преобразоват. момент. ток через обм. 16-10 (16-6) силового тр-ср. TV1 и намагничивает сердечник TV1. Через токовую обм. TV2-2 обм. 7-5 создается полож. обр. связь по току и обеспечив-ся форсированное открывание VT2. При этом вторичные обм. TV1-4 намотаны противофазно обм. 16-10, в них создается обратн. напряж. & ЭДС индукц. и демодул. - не пропускают этот ток. Вся энергия идет в наклонный феррит и не идет на нагрузку.

Сх. защиты по перегр. по I TV1 в DA1 приводится в ред. состоянии при 1 загл. или при заряде C2...C8 R13-R14. Контр. коллект. тока осущ. по падению U на резист. R11, R12 (R9). В мунт. Iкал. > 3а проих. мунтарование обмотки 1-2 TV2-1. За счет возм. шп. на 14 ноге DA1. VT1 запрещает за счет U на эмиттере. Огранич. по току определяют R10, (R8) и резист. центр.

Для запуска сх. управл. и выработки генерации и управляющих импульсов намотаны шп. фазная обм. TV1-5 первичная обм. 2-13. (3-5). (рис 8 интервал 0-T1) Зарядка C53 (C35). Подключается U, обеспечивающее вклот. микросб. DA6 (DA5) - порядка 8в. DA6 включается в работу. С ножки 16 DA6 снимается полож. импульс, который открывает VT2 (КТ808АМ), намагничивает сердечн. TV2-3 обм. 10-9, через ~~интервал~~ ~~фрагмент~~ R22 (R17)

Следующим шп. 16 ноге (мунт. шп.) T1, T2 (врем. дианр. шп.) запрещает VT2 - проих. протекание Ii через обм. 8-6 TV2-3. В базу VT1 через диод VD6 VD7 и открывает VT1. В момент T2(а) на базу VT2 снова подается полож. шп. с DA6 (нагрузка с (-40кГн), VT2 открывает мунтар. обм. 9-10 через диод VD18 (VD12), при этом заряд конденсатор C29 (C22) Базовая цепь VT1 подключается через зашунтированную обм. 8-6 отриц. обкладкой порядка 1,-2в. к базе VT1. U на C29 создает шп. и I течет на оборот через обм. и шп. & базу.

Т2-Т3 происходит рассасывание базы и идёт закрытие базы. Т.е. в момент Т3 в коллектора резко возрастает и во всех вторичн обмотках TV1 меняются знаки. Это значит идёт отток энергии. Ток намагничив. TV 1-4 протекает через вторичн. обмотки. Через обмотку сброса 14-24 (10-18) TV1,2 и через диоды в модуляторе каналов заряжаем соответств. емкости сглаживающего фильтра.

Цепь обм. сброса ограничивает всплеск в индукт. на колл. VT1. Т.е. предохранит от пробоя. U_{max} на VT1 680В. В момент Т4 диод VD3 обмот. сброса запирается. Ток через 14-24 TV1,2 (10-18) прекращается. Дальнейшее размагничивание артефакт, происх. за счет протекания тока во втор. обмотках в нагрузку и в конденс. Это инт. процесс Т3-Т5. В момент Т5 процесс повторяется.

Для уменьш. импульсн. мощн. при запуске VT1 исполз. цепочка коррекции R15, R16, VD4, VD5, C23 обмот. TV1,3 обм. 12-22 (2-4). Происходит затухание фронта при закрытии VT1*

После вых. с П и нахвостик на выходных каналах вых.дн. нагрузка, - на каналах +12, -12, ±12 ставятся инейные стабилизаторы

Дальнейшее питание DA6 осуществляется от канала +12В. Обратн. связь по U каналам 5В для управл. воздействием на управл. DA6 стк. на емк. с 5В. и подает на ножки 9,10. Перемен. копр. R26 (R23) осуществляет регулировку уровня опорного напряжения. Ножка 12 ножка ж. опорное усилит. ~90В (сл. макс. 60В)

* Для ↓ импульсн. мощн. при запуске VT1 испол. цепочка коррекции из R15, R16, VD4, VD5, C23 и TV1 12-22 (R13, R14, VD4,5, C23, TV1 2-4). Диод при открытии TV1 пропускает в обмотки 12-22 (2-4) и ограничивает р-р-ем R15 (R13). При запуске VT1 диод VD4 фиксирует потенциал к. VT1 на уровне, опр. 12-22 (2-4) за счёт т. ^{за R26 с 23} VD4 → затухание фронта и на коллекторе по t → P. Ресурсы конденсатора - через резисторы

Программное обеспечение

Операционная система - совокупность программных средств обесп. управл. аппаратн. ресурсами вычисл. систем и взаимодейств. программных процессов с аппаратурой, и другими процессами и с пользователем.

Фунд. опер. сист.: управление памятью, управл. выводом, управл. файловой системой, управ. взаимодействием процессов, диспетчеризация процессов, защита и учет использования ресурсов - раз. оп, диск. обработка командного языка.

Операционная система: MS DOS (для 16 разр. машин) ^{однопользовательск.} Однопрограммная гибкая файловая структура. CP/M-86 для 8 разр. процессоров. UNIX - мультипрограммная, многопользоват. Командный язык C. 3-5 мбайт на внешних носителях ^{чуть выше стандарта}

MS DOS - развит. командный язык, гибкая файловая структура. (Орган. многоуровневых каталогов) возм. работы со всеми носителями. Упр-дн. в/б как с файлами. Возм. подмот. пользователем доп. устр-в. Врайверов доп. устр-в. Для общ. с нестандартн. устр-вами.

Выполн. фоновой задачи с одновременн. фоновой работой. имеется в виду распечатка на печати.

Файл - это именованная целостная совокупность данных на внешнем носителе.

< имя > . < расширение >
 1 ÷ 8 симв. 0 ÷ 3 символов
 пример: 545 - значит файл системный
 .BAT } командные файлы, т.е. готовые
 .COM } произр. продукт.
 .EXE } указ. в коней или в работе своб. зоны от записи.
 .ASM - ассемблер, что про гр. написан на ассемблере